

# HDP-CVD 低温高密度SiO<sub>2</sub>

PEGASUSは、高密度プラズマのガス分解効率と高真空下のデポジションで、200°C以下の低温でも**熱酸化膜に近い**高密度膜を成膜する事が出来ます

装置：PEGASUS (HDP-CVD)

サイズ：φ2~12inch

基板：Si、SiC、GaN、LT、GaAs、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Glass

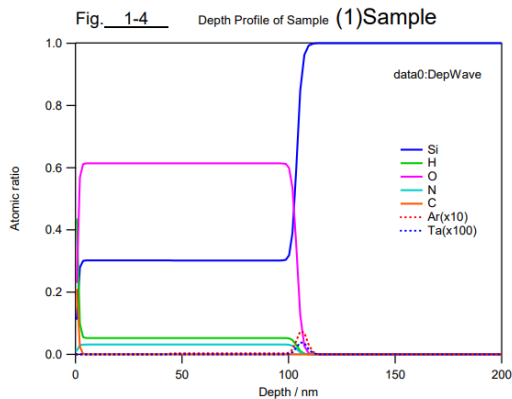
温度：<200°C



## 特性

耐電圧	リーク電流	膜密度	水素量	BHFレート
10MV/cm	$2 \times 10^{-9}$ A/cm <sup>2</sup>	2.35g/cm <sup>3</sup>	5.3%	90nm/min

### 水素含有量 (RBS)



### カバレッジ

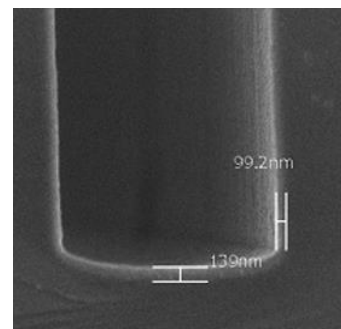


Fig. 1-5 Depth Profile of Sample (1)Sample  
Toray Research Center, Inc.

## 用途

- ・パワーデバイスゲート絶縁膜 (SiC、GaN)
- ・メモリ (MRAM)
- ・ハードマスク (ドライエッチング、イオン注入)